

Содержание

Горбенко И.В., Качоровский В.Ю.

Управление зонной структурой латерального плазменного кристалла магнитным полем 115

Краснова И.А., Закиров Е.Р., Сидоров Г.Ю., Сабина И.В.

Низкотемпературные обработки поверхности CdHgTe методом PE-ALD перед осаждением HfO₂ 120

Чернышова Е.В., Росляков С.И., Ермакова Ж.С., Аргунов Е.В., Московских Д.О., Юдин С.Н., Ховайло В.В.

Термоэлектрические свойства перовскита CaMnO₃, синтезированного методом горения реакционных аэрозолей . . 126

● **Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)**

Лундин В.В., Заварин Е.Е., Сахаров А.В., Казанцев Д.Ю., Бер Б.Я., Цацульников А.Ф.

Исследование влияния условий роста на легирование GaN углеродом из пропана и метана 134

● **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Чернов М.Ю., Соловьев В.А., Дричко И.Л., Смирнов И.Ю., Иванов С.В.

Влияние конструкции и условий роста метаморфных гетероструктур In(Ga,Al)As/GaAs на электрофизические параметры двумерного канала In_{0.75}Ga_{0.25}As/InAlAs 142

● **Физика полупроводниковых приборов**

Шестериков А.Е., Шестерикова Д.А., Ерофеев Е.В.

Исследование конструктивно-технологических особенностей изготовления малошумящих GaAs-транзисторов с длиной Т-затвора 150 нм для систем передачи информации 149

Жидяев К.С., Чигинева А.Б., Байдусь Н.В., Самарцев И.В., Кудрин А.В.

Исследование влияния топологии полосковой мезоструктуры на основные параметры низковольтного GaAs-тиристора 156

Подоскин А.А., Шушканов И.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Светогоров В.Н., Яроцкая И.В., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симаков В.А.

Низковольтные токовые ключи на основе гетероструктур тиристоры Al-In-Ga-As-P/InP для импульсных лазерных излучателей (1.5 мкм) наносекундной длительности . . . 161

Подоскин А.А., Шушканов И.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Светогоров В.Н., Рябоштан Ю.Л., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симаков В.А.

Гибридные сборки тиристорный ключ-полупроводниковый лазер на основе гетероструктур Al-In-Ga-As-P/InP для мощных импульсных источников лазерного излучения (1400–1500 нм) 165